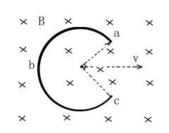
电磁学部分测试

- 一、填空题(每题4分,共24分)
- **1.** 一空气平行板电容器的极板面积为 S,板间距离为 d ,现将其中一半充满相对介电常数为 $\varepsilon_r=2$ 的介电质,如图所示,则电容器的电容为_____。



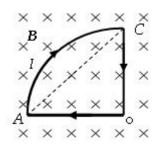
2. 螺绕环中心周长 L=10cm,环上均匀密绕线圈 N=200 匝,线圈中通有电流 I=100mA。若管内充满相对磁导率为 $\mu_r=4200$ 的磁性物质,则管内的磁感应强度的大小 $B=_1.05$ T,磁场强度的大小 $H=_200$ A/m $_$ 。

3. 如图所示,导线 abc 的形状为半径为 R 的 3/4 圆周,导线沿 $\angle aoc$ 的分角线方向以速度 v 水 平向右运动,则导线上的动生电动势大小为 $\sqrt{2}BRV$,指向 $\mathbf{c} \longrightarrow \mathbf{b} \longrightarrow \mathbf{a}$ 。



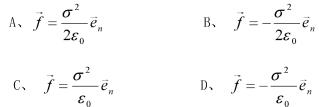
4. 在真空中有 $A \times B$ 两板,相距为 d,板面积均为 s,分别带电量+ $q \times -q$,则两板之间的作用力为______。

- **5.** 一无限长直导线载有电流 I,中部弯成 $\frac{1}{4}$ 圆周,圆心为 O,半径为 a,则 O 点的磁感强度为______。
- **6.** 如图所示,一线圈由半径为0.2m 的1/4 圆弧和相互垂直的二直线组成,通以电流2A,把它放在磁感应强度为0.5T 的均匀磁场中。则:当线圈平面与磁场垂直时,圆弧 \mathcal{L} 所受的磁力大小为 0.283 N ,线圈所受的磁力矩大小为 0.280 。



二、单项选择题(每题4分,共24分)

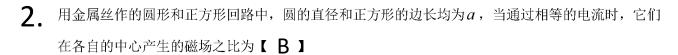
在静电平衡条件下,导体表面上的电荷面密度为 σ , \bar{e}_n 为指向导体外部的法向单位矢量,则导体 表面单位面积受到的电场力为【 A 】



B,
$$\vec{f} = -\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \vec{e}_n$$

$$C, \quad \vec{f} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0} \vec{e}_n$$

$$D, \quad \vec{f} = -\frac{\sigma^2}{\varepsilon_0} \vec{e}_i$$



- A. 1 B. $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ C. $\sqrt{2}\pi$ D. $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$

D.
$$\frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

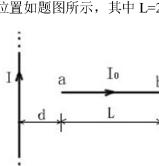
一根长为 L 的细铜杆 ab 与载流长直导线在同一平面内,相对位置如题图所示,其中 L=2d,如果铜 杆中通以电流 I_0 ,那么铜杆所受的安培力如何?【 B 】

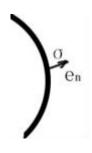
A、
$$F = \frac{\mu_0 II_0}{2\pi} \ln 2$$
,方向: 竖直向上

B、
$$F = \frac{\mu_0 II_0}{2\pi} \ln 3$$
,方向: 竖直向上

$$C \cdot F = \frac{\mu_0 II_0}{2\pi} \ln 3$$
,方向: 竖直向下

D、
$$F = \frac{\mu_0 II_0}{2\pi} \ln 2$$
, 方向: 竖直向下





4. 无限长载流直圆柱体,半径为 R,电流 I 均匀流过圆柱体。P 点到圆柱体轴线的垂直距离为 R。设 圆柱体内 $(r\langle R)$ 的磁感应强度为 B_A ,圆柱体外 $(r\langle R)$ 的磁感强度为 B_A 。则【C】

A、B_b、B_b都与r成正比

B、 B n、B n都与 r 成反比

C、B_A与r成正比,B_A与r成反比 D、B_B与r成反比,B_A与r成正比

5. 根据场强与电势梯度的关系式 $\vec{E} = -\frac{d\varphi}{dr}\vec{n}$, 可判断以下结论正确的是【 D 】

A、场强为零处, 电势一定为零

B、电势为零处,场强一定为零

 \mathbf{C} 、场强处处相等的区域,电势一定处处为零 \mathbf{D} 、电势处处相等的区域,场强一定处处为零

6. 空气平板电容器U不变而减小d,则(A)

A、Q增大,E增大,We增大 B、Q减少,E减少,We减少

C、Q增大,E减少,We增大 D、Q增大,E增大,We减少

- 三、判断题(每题2分,共12分)
- 1. 静电场的环路定理 $\oint_{l} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 说明静电场是保守场。

[/]

2. 由安培环路定理 $\oint_L \vec{H} \cdot dl = \sum_I$ 可确定,若闭合环路内没有包围传导电流,则环路上各

点的 \bar{H} 必为零;

 $[\times]$

3. 由线圈自感系数 L 的定义式 $L = \frac{\Phi}{I}$ 可知, I 越小, L 就越大。

 $[\times]$

- 4. 高斯定理 $\iint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = \sum_s q$ 可知,高斯面上各点 \vec{D} 仅由面内自由电荷决定。 【 \times 】
- 5. 当一个导体带电时,表面上电荷密度较大的电势较高。

 $[\times]$

6. 磁场的高斯定理 $\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ 说明磁场是无源场。

[,]

四、计算题(每题20分,共40分)

1、设有一半径为,电荷为的导体球A,球外套一个半径为,电荷为的同心导体薄球壳B。A,B间充有两层电介质,内外层介质的相对介电常数和,两层介质的分界面的半径为。试求: (1)电场强度分布; (2)A、B间的电势差; (3)球A的电势。

解:(1)以球心O为原点,以r为半径作一球形高斯面,

根据电介质中的高斯定理,有

$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 4\pi r^{2} = \sum Q_{i}$$

$$D = \frac{\sum Q_i}{4\pi r^2} \quad , \quad E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\sum Q_i}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} \quad (4\%)$$

则在 $r < R_1$ 的球A内, $\sum Q_i = 0$,有 $D_0 = 0$, $E_0 = 0$

(2分)

在
$$R_1 < r < R_2$$
的第一层电介质中, $\sum Q_i = Q_A$,有 $D_1 = \frac{Q_A}{4\pi r^2}$, $E_1 = \frac{Q_A}{4\pi \epsilon \epsilon r^2}$ (2分)

在
$$R_2 < r < R_3$$
的第二层电介质中, $\sum Q_i = Q_A$,有 $D_2 = \frac{Q_A}{4\pi r^2}$, $E_2 = \frac{Q_A}{4\pi \varepsilon_o \varepsilon_o r^2}$ (2分)

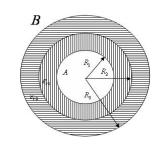
在
$$r > R_3$$
的真空中, $\sum Q_i = Q_A + Q_B$,有 $D_3 = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi r^2}$, $E_3 = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$ (2分

(2) 由电势差定义可知, A、B 两球壳间的电势差为

$$\begin{split} U_{AB} &= \int_{A}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \vec{E}_{1} \cdot d\vec{r} + \int_{R_{2}}^{R_{3}} \vec{E}_{2} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{Q_{A}}{4\pi\varepsilon_{0}\varepsilon_{r_{1}}r^{2}} dr + \int_{R_{2}}^{R_{3}} \frac{Q_{A}}{4\pi\varepsilon_{0}\varepsilon_{r_{2}}r^{2}} = \frac{Q_{A}}{4\pi\varepsilon_{0}} \left[\frac{1}{\varepsilon_{r_{1}}} \left(\frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}} \right) + \frac{1}{\varepsilon_{r_{2}}} \left(\frac{1}{R_{2}} - \frac{1}{R_{3}} \right) \right] \end{split} \tag{4.75}$$

(3) 取无穷远为电势零点,有

$$\begin{split} V_A &= \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_B^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= U_{AB} + \int_{R_0}^\infty \vec{E}_3 \cdot d\vec{r} = U_{AB} + \int_{R_0}^\infty \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = U_{AB} + \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\varepsilon_0 R_3} \end{split} \tag{4.7}$$



 $\mathbf{2}$. 在半径为 R 圆柱形区域内,沿轴向有一均匀磁场,一等边三角形金属框置于该磁场中,如题图所

示,
$$O$$
 点为圆心, $PQ=QM$,磁感应强度 B=0.8T,且 $\frac{dB}{dt}$ 以恒定值 0.1T/s

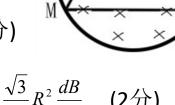
增加,求(1)o.P.Q 三点的感生电场的大小和方向。(2)M.N 边的感生电动势。

(3) 若金属框得总电阻为 R_0 , 感生电流为多少? 方向如何?

(1)

$$E_o = 0$$
, $E_P = -\frac{R}{2} \frac{dB}{dt}$, $E_Q = -\frac{R}{4} \frac{dB}{dt}$ (6分,每个2分)

$$\varepsilon_{oM} = \varepsilon_{oN} = \int_{L} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l} = 0$$
 $\varepsilon_{MN} = \varepsilon_{\Delta oMN}$ (2 $\%$)



$$\phi = \iint_{s} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\sqrt{3}}{4} R^{2} B \left(4 \mathcal{D}\right) \varepsilon_{MN} = \varepsilon_{\Delta oMN} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\sqrt{3}}{4} R^{2} \frac{dB}{dt} \qquad (2 \mathcal{D})$$

(3)

$$\varepsilon_{MNP} = 3\varepsilon_{MN} = -\frac{3\sqrt{3}}{4}R^2\frac{dB}{dt} \quad (4\%)I = \frac{\varepsilon_{MPN}}{R} = -\frac{3\sqrt{3}}{4R_0}R^2\frac{dB}{dt} \quad (2\%)$$
 逆时针方向